

Single

Fast Recovery Diode

SG10L20USM
200V 10A
特長

- 高速スイッチング

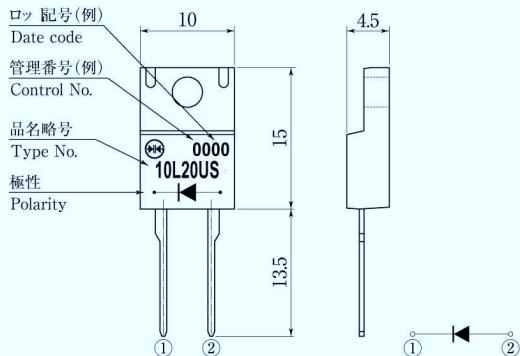
Feature

- High Recovery Speed

■外観図 OUTLINE

Package : FTO-220G

Unit:mm



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

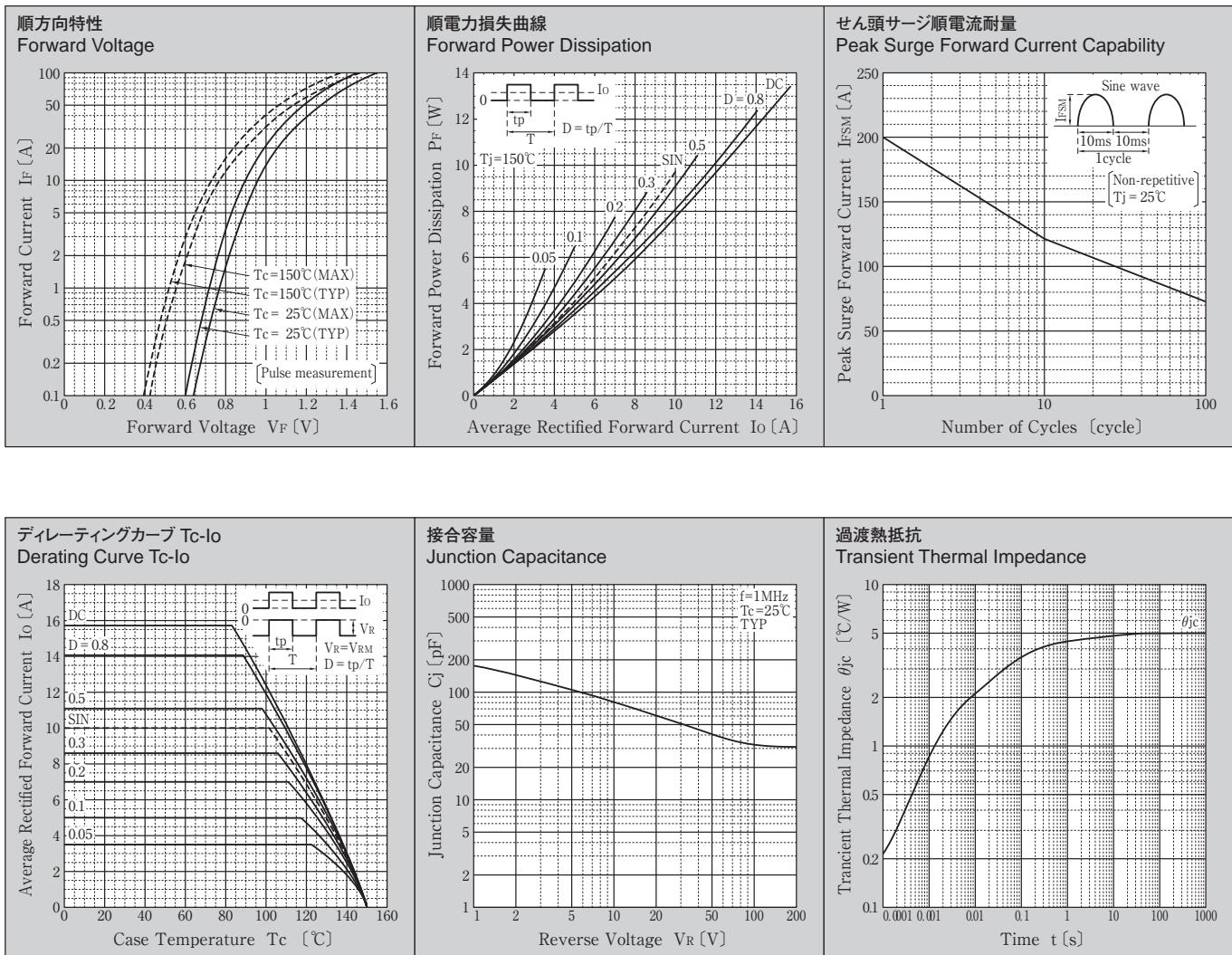
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25°C)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}		200	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, T _c = 101°C 50Hz sine wave, Resistance load, T _c = 101°C	10	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T _j = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T _j = 25°C	200	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース裏面間, AC 1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	1.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	T _{OR}	(推奨値: 0.3 N·m) (Recommended torque: 0.3N·m)	0.5	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 10A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.96 TYP 0.91	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = 200V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I _F = 0.5A, I _R = 1.0A, 0.25 I _R	MAX 25	ns
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V	TYP 80	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 5	°C/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.